

## E. Compound Semiconductors 분과

Room E  
창의관 (B113)

일 시 : 2월 17일(금) 11:20-12:35

세션명 : [FE2-E] Electronics Devices and Processes II

좌 장 : 이정희(경북대학교), 차호영(홍익대학교)

- 
- FE2-E-1 11:20-11:50 **[Invited]** 차세대 국방레이더 트랜시버용 GaN 전자소자 제조공정 기술 개발  
저자: 문재경  
소속: 한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부 RF융합부품연구팀
- FE2-E-2 11:50-12:05 Crack-free AlGaIn/GaN HFET Grown on 6-inch Si substrate  
저자: J. M. Kim, K. C. Kim, E. J. Hwang, S. M. Cho, and T. H. Jang  
소속: IGBT part, LG Electronics Inc.
- FE2-E-3 12:05-12:20 Characteristics of AlGaIn/GaN-based FinFET using High Quality ALD Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as Gate Dielectric  
저자: Ki-Sik Im, Ki-Won Kim, Dong-Seok Kim, Hee-Sung Kang, Sung-Dal Jung, Chan-Ho Bu, Chul-Ho Won, Ryun-Hwi Kim, Kyu-Il Jang, Mi-Kyung Kwon, and Jung-Hee Lee  
소속: School of Electrical Engineering and Computer Science, Kyungpook National University
- FE2-E-4 12:20-12:35 X-band용 6W AlGaIn/GaN HEMT 소자의 특성  
저자: 김성일, 윤형섭, 강동민, 민병규, 안호균, 주철원, 이종민, 이상흥, 임종원, 김해천, 문재경, 남은수  
소속: ETRI 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구팀 RF융합부품연구팀